

2SK133, 2SK134, 2SK135

SILICON N-CHANNEL MOS FET

低周波・高周波電力増幅, 高速度電力スイッチング
2SJ48, 2SJ49, 2SJ50とコンプリメンタリペア

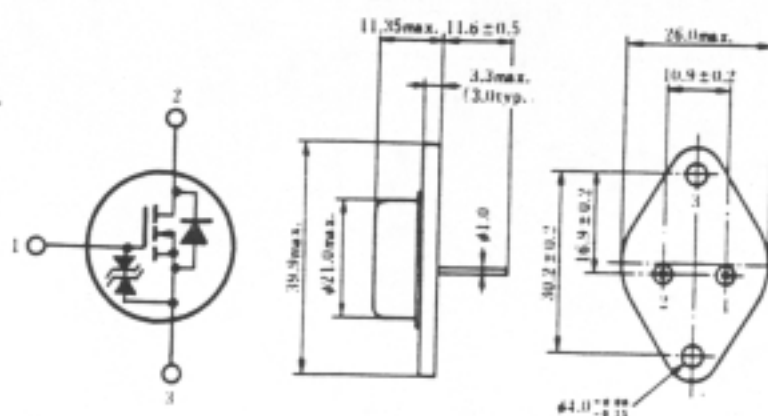
■ 特 長

- 周波数特性が優れている。
- スwitchングスピードが速い。
- 安全動作領域(ASO)が広い。
- エンハンスメント特性。
- コンプリメンタリ性が良い。
- ゲートに保護ダイオードを内蔵。
- オーディオアンプ出力, モータコントロールなどに最適。

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rating			Unit
		2SK133	2SK134	2SK135	
Drain-Source Voltage	V_{DS}	120	140	160	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 14			V
Drain Current	I_D	7			A
Body-Drain Diode Reverse Drain Current	I_{DS}	7			A
Channel Dissipation	P_{ch} *	100			W
Channel Temperature	T_{ch}	150			$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	$-55 \sim +150$			$^\circ\text{C}$

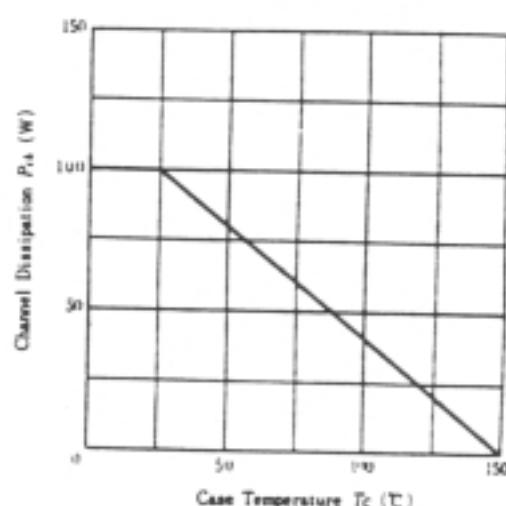
*Value at $T_c=25^\circ\text{C}$



1. Gate
2. Drain
3. Source (Case)
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

POWER VS. TEMPERATURE DERATING



■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DS}$	$I_D=10\text{mA}, V_{GS}=-10\text{V}$	120	—	—	V
			140	—	—	V
			160	—	—	V
Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GS}$	$I_G=\pm 100\mu\text{A}, V_{DS}=0$	± 14	—	—	V
Gate-Source Cutoff Voltage	$V_{GS(off)}$	$I_D=100\text{mA}, V_{DS}=10\text{V}$	0.15	—	1.45	V
Drain-Source Saturation Voltage	$V_{DS(sat)}$	$I_D=7\text{A}, V_{GS}=0^*$	—	—	12	V
Forward Transfer Admittance	$ y_{fs} $	$I_D=3\text{A}, V_{DS}=10\text{V}^*$	0.7	1.0	1.4	S
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=-5\text{V}, V_{DS}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	600	—	pF
Output Capacitance	C_{oss}		—	350	—	pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rs}		—	10	—	pF
Turn-on Time	t_{on}	$V_{DS}=20\text{V}, I_D=4\text{A}$	—	180	—	ns
Turn-off Time	t_{off}		—	60	—	ns

*Pulse Test